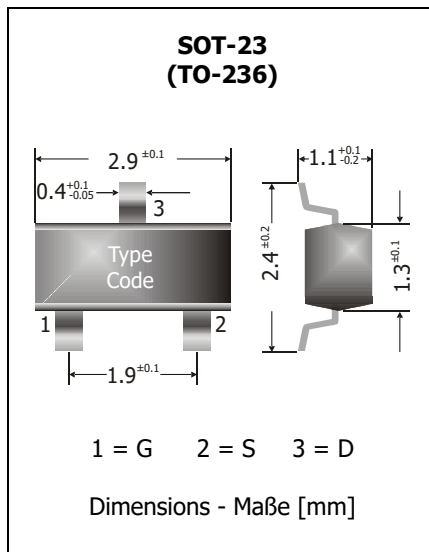


**MMBT7002K**  
**N-Channel Enhancement Mode FET**  
**N-Kanal FET – Anreicherungstyp**

$I_D$	= 300 mA	$V_{DSS}$	= 60 V
$R_{DS(on)1}$	< 3 $\Omega$	$P_{tot}$	= 350 mW
$T_{jmax}$	= 150°C	$V_{GSS1}$	= $\pm$ 2 kV

Version 2017-05-30

**Typical Applications**

Signal processing, Logic level converter, Drivers  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

ESD protected Gate  
 Fast switching times  
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled	3000 / 7 <sup>n</sup>
Weight approx.	0.01 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1

**Typische Anwendungen**

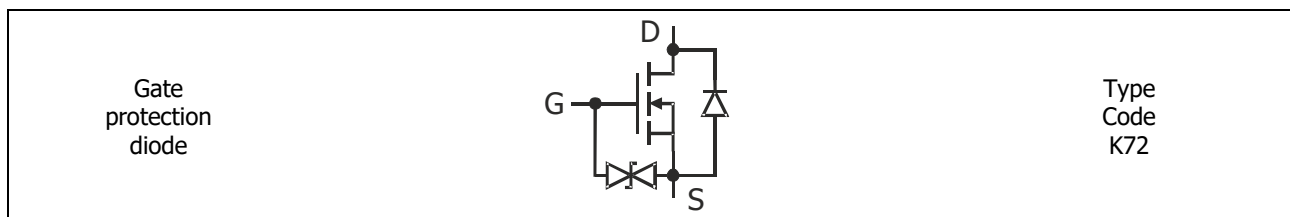
Signalverarbeitung, Pegelwandler, Treiberstufen  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

ESD geschütztes Gate  
 Schnelle Schaltzeiten  
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Drain-Source-voltage Drain-Source-Spannung		$V_{DSS}$	60 V
Gate-Source-voltage Gate-Source-Spannung	dc ESD	$V_{GSS}$	$\pm$ 20 V $\pm$ 2 kV
Power dissipation Verlustleistung		$P_{tot}$	350 mW
Drain current Drainstrom	dc	$I_D$	300 mA
Peak Drain current Drain-Spitzenstrom		$I_{DM}$	800 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-55...+150°C -55...+150°C

<sup>1)</sup> Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
<sup>2)</sup>  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben

**Characteristics**
**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung $I_D = 10 \mu\text{A}$		$BV_{DSS}$	60 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom $V_{DS} = 60 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$		$I_{DSS}$	–	–	1 $\mu\text{A}$
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom $V_{GS} = 20 \text{ V}$		$\pm I_{GSS}$	–	–	10 $\mu\text{A}$
Gate-Threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250 \mu\text{A}$		$V_{GS(th)}$	1 V	–	2.5 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand $V_{GS} = 10 \text{ V}, I_D = 500 \text{ mA}$ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}, I_D = 200 \text{ mA}$		$R_{DS(on)}$	–	–	3 $\Omega$ 4 $\Omega$
Forward Transconductance – Übertragungsteilheit $V_{DS} \geq 10 V_{DS(on)}, I_D = 200 \text{ mA}$		$g_{FS}$	80 mS	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		$C_{iss}$	–	50 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		$C_{oss}$	–	25 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		$C_{rss}$	–	5 pF	–
Turn-On Time – Einschaltzeit $V_{DD} = 30 \text{ V}, R_L = 150 \Omega, I_D = 0.2 \text{ A}, V_{GS} = 10 \text{ V}, R_G = 25 \Omega$		$t_{on}$	–	20 ns	–
Turn-Off Delay Time – Ausschaltverzögerung $V_{DD} = 30 \text{ V}, R_L = 150 \Omega, I_D = 0.2 \text{ A}, V_{GS} = 10 \text{ V}, R_G = 25 \Omega$		$t_{off}$	–	20 ns	–

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)